


MATERIAL SUPLEMENTAR

Semicondutores heteroestruturados: uma abordagem sobre os principais desafios para a obtenção e aplicação em processos fotoquímicos ambientais e energéticos

Romero T. Bueno^a, Osmando F. Lopes^b, Kele T. G. Carvalho^c, Caue Ribeiro^{c,d,*},  e Henrique A. J. L. Mourão^a

^aInstituto de Ciência e Tecnologia, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 39100-000 Diamantina – MG, Brasil

^bInstituto de Química, Universidade Federal de Uberlândia, 38400-902 Uberlândia – MG, Brasil

^cLaboratório Nacional de Nanotecnologia para o Agronegócio, Embrapa Instrumentação, 13561-206 São Carlos – SP, Brasil

^dForschungszentrum Jülich GmbH, Institute of Energy and Climate Research (IEK-3): Electrochemical Process Engineering, 52425 Jülich, Germany

*e-mail: caue.ribeiro@embrapa.br

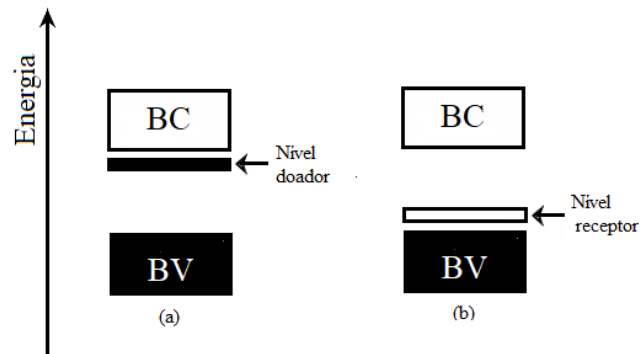


Figura 1S. a) Esquema da banda de energia em um semiconductor do tipo n: e^- introduzidos no nível doador podem acessar com facilidade a BC; b) Esquema da banda de energia para um semiconductor do tipo p: a excitação de e^- da BV para o nível receptor gera h^+ na BV